

少子寿命测试仪(HS-CLT)

产品名称	少子寿命测试仪(HS-CLT)
公司名称	北京合能阳光新能源技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:HenergySolar 型号:HS-CLT 测量范围:0.1 μ s-30ms
公司地址	北京市通州区工业开发区光华路16号综合楼A207
联系电话	010-60546837 13718294863

产品详情

品牌	HenergySolar	型号	HS-CLT
测量范围	0.1 μ s-30ms	电源电压	220 (V)
用途	用于硅半导体的测量		

【官方网址】<http://www.henergysolar.com/product/hs-clt.htm>合能阳光少子寿命测试仪(hs-clt)，是一款功能强大的少子寿命测试仪，不仅适用于硅片少子寿命的测量，更适用于硅棒、硅芯、检磷棒、检硼棒、籽晶等多种不规则形状硅少子寿命的测量。少子测试量程从1 μ s到6000 μ s，硅料电阻率下限达0.1 Ω .cm(可扩展至0.01 Ω .cm)。测试过程全程动态曲线监控，少子寿命测量可灵敏地反映单晶体重金属污染及陷阱效应表面复合效应等缺陷情况，是原生多晶硅料及半导体及太阳能拉晶企业不可多得少子寿命测量仪器。

少子寿命测试仪-产品特点 测试范围广：包括硅块、硅棒、硅芯、检磷棒、检硼棒、籽晶、硅片等的少子寿命及锗单晶的少子寿命测量。 主要应用于硅棒、硅芯、检磷棒、检硼棒、籽晶、硅块、硅片的进厂、出厂检查，生产工艺过程中重金属沾污和缺陷的监控等。 适用于低阻硅料少子寿命的测量，电阻率测量范围可达 $> 0.1 \Omega$.cm (可扩展至0.01 Ω .cm)，完全解决了微波光电导无法检测低阻单晶硅的问题。 全程监控动态测试过程，避免了微波光电导(u-pcd)无法观测晶体硅陷阱效应，表面复合效应缺陷的问题。 贯穿深度大，达500微米，相比微波光电导的30微米的贯穿深度，真正体现了少子的体寿命的测量，避免了表面复合效应的干扰。 专业定制样品架最大程度地满足了原生多晶硅料生产企业测试多种形状的硅材料少子寿命的要求，包括硅芯、检磷棒、检硼棒等。 性价比高，价格远低于国外国外少子寿命测试仪产品，极大程度地降低了企业的测试成本。少子寿命测试仪-推荐工作条件 温度：23 \pm 2 湿度：60%~70% 无强磁场、不与高频设备邻近少子寿命测试仪-

技术指标 测试材料：硅半导体材料-

硅棒、硅芯、检磷棒、检硼棒、籽晶、硅块、硅片等，锗半导体材料。 少子寿命测试范围

:1 μ s-6000 μ s 可测低阻硅料下限：0.1 Ω .cm,可扩展到0.01 Ω .cm 激光波长：

1.07 μ m 激光在单晶硅中的贯穿深度：500 μ m 工作频率：30mhz 低输出阻抗，输出功率 $>$

1w 电源：~220v 50hz 功耗 $<$ 50w少子寿命测试仪-典型用户北京，浙江，四川，河北，河南等地的硅料生产企业及半导体光伏拉晶客户电子邮件咨询:sales@henergysolar.com